

Сведения об официальном оппоненте

Глазов Михаил Михайлович

Электронная почта: glazov@coherent.ioffe.ru

Ученая степень: доктор физико-математических наук

Специальность: 01.04.10 - физика полупроводников

Академическое звание: член-корреспондент РАН

Место работы

Место работы: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук, Лаборатория спиновых и оптических явления в полупроводниках

Должность: ведущий научный сотрудник

Тел.: +7 (911) 913-04-36

E-mail: glazov@coherent.ioffe.ru

Почтовый адрес: 194021, Россия, Санкт-Петербург, Политехническая ул., 26

Список основных публикаций оппонента по теме диссертации в рецензируемых научных изданиях за последние 5 лет:

1. Fomin A. A. et al. Anomalous light-induced broadening of the spin-noise resonance in cesium vapor //Physical Review A. – 2021. – Т. 103. – №. 4. – С. 042820. DOI: 10.1103/PhysRevA.103.042820
2. Linpeng X. et al. Optical spin control and coherence properties of acceptor bound holes in strained GaAs //Physical Review B. – 2021. – Т. 103. – №. 11. – С. 115412. DOI: 10.1103/PhysRevB.103.115412
3. Glazov M. M., Suris R. A. Collective states of excitons in semiconductors //Physics-Uspekhi. – 2020. – Т. 63. – №. 11. – С. 1051. DOI: 10.3367/UFNe.2019.10.038663
4. Glazov M. M., Golub L. E. Skew Scattering and Side Jump Drive Exciton Valley Hall Effect in Two-Dimensional Crystals //Physical Review Letters. – 2020. – Т. 125. – №. 15. – С. 157403. DOI: 10.1103/PhysRevLett.125.157403
5. Durnev M. V. et al. Microscopic model for the stacking-fault potential and the exciton wave function in GaAs //Physical Review B. – 2020. – Т. 101. – №. 12. – С. 125420. DOI: 10.1103/PhysRevB.101.125420
6. Kosarev A. N. et al. Microscopic dynamics of electron hopping in a semiconductor quantum well probed by spin-dependent photon echoes //Physical Review B. – 2019. – Т. 100. – №. 12. – С. 121401. DOI: 10.1103/PhysRevB.100.121401
7. Förg M. et al. Cavity-control of interlayer excitons in van der Waals heterostructures //Nature communications. – 2019. – Т. 10. – №. 1. – С. 1-6. DOI: 10.1038/s41467-019-11620-z
8. Fang H. H. et al. Control of the exciton radiative lifetime in van der Waals heterostructures //Physical review letters. – 2019. – Т. 123. – №. 6. – С. 067401. DOI: 10.1103/PhysRevLett.123.067401

9. Lundt N. et al. Optical valley Hall effect for highly valley-coherent exciton-polaritons in an atomically thin semiconductor //Nature nanotechnology. – 2019. – T. 14. – №. 8. – C. 770-775. DOI: 10.1038/s41565-019-0492-0
10. Shamirzaev T. S. et al. Intrinsic and magnetic-field-induced linear polarization of excitons in ultrathin indirect-gap type-II GaAs/AlAs quantum wells //Physical Review B. – 2019. – T. 99. – №. 15. – C. 155301. DOI: 10.1103/PhysRevB.99.155301
11. Manca M. et al. Electrically tunable dynamic nuclear spin polarization in GaAs quantum dots at zero magnetic field //Applied Physics Letters. – 2018. – T. 112. – №. 14. – C. 142103. DOI: 10.1063/1.5024619
12. Wang G. et al. In-plane propagation of light in transition metal dichalcogenide monolayers: optical selection rules //Physical review letters. – 2017. – T. 119. – №. 4. – C. 047401. DOI: 10.1103/PhysRevLett.119.047401
13. Manca M. et al. Enabling valley selective exciton scattering in monolayer WSe₂ through upconversion //Nature communications. – 2017. – T. 8. – №. 1. – C. 1-7. DOI: 10.1038/ncomms14927